공개특러 97-72358 1/2

☞대한민국특허청(KCR) ☞공 개 특 허 공 보(A)

(D) Int. Cl. (1) II 01 L 23/50

제 2658 호

∰공개인자 1997. 11. 7

⑩공개번호 97-72358

❷출원일자 1996. 4. 1

외출원번호 96− 9774

십사경구 : 있음

□ 말 및 자 혀 열 육 경기도 성남시 분당구 수내동 55 롯데이파트 132·1504

🔞 출 원 인 아님산업 주식회사 대표이사 황 인 신

서울특별시 성공구 성수 2가 280-8 (우: 133-120)

M 대리인 변리사 서 만 규

(전 2 면)

9 반도체패키지의 제조빙법 및 구조

원 장 하

문 발명은 반도체패키지의 제조방법 및 구조에 관한 것으로, 반도체칭의 저면을 의부로 노출시켜 회로통작시 발생되는 얼당출의 효과를 국대화하여 패키지의 수명을 연장시키고, 신의성을 항상시킨은 불론, 패키지의 물명 부 외축에 위치한 리드는 것단하고, 물명부 내축에 위치한 비드는 그 저면은 외부로 노출시켜 마디보드에 실장 사 티드의 저면에서 신호전달을 하도록 함으로서 실장면적을 최소할 수 있는 반모체패키시이다. 공개특허 97-72358 2/2

특허청구의 범위

1. 디수의 리트가 형성되고, 상기 다수의 리드 중앙부에는 침탑재판이 없는 리드프레임을 형성하는 반세와: 상기 리트프레임의 다수의 비느 중앙부에 만도제침을 위치시켜 와이어본당을 실시하는 단계와: 상기 와이어본 당된 리드, 반도계칭 및 와이어를 의부의 산회 및 부칙으로부터 보호하기 위하여 몰당하는 단계와: 상기 단계 후에 물당영역 의자에 위치한 리드를 절단하는 단계로 이두어진 것을 특성으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

2. 제1항에 있어서, 상기 와이어본당은 배물 홈(Vacuum Hole)이 형성된 히디블릭에 반도세칩을 위치시켜 상기 배큠 홈로 공기를 빨아들여 반도제칩을 지지 고정하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

3. 게1항에 있어서, 상기 불당단계는 액상 봉지재를 사용하여 몰당하는 것을 묵장으로 하는 반도제패키지의 제소방법.

4. 제1형 또는 3항에 있어서, 역상 봉지재를 시용하여 물당하기 전에 물당영역에 단을 형성하여 역상 봉지재가 가 끌린 남치는 것을 받지하는 것을 특징으로 하는 반노제패기자의 제조방법.

5. 세1항에 있어서, 삼기 몰림단자는 물드 침파운드를 사용하여 돌덩하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지 의 제조방법.

6. 저3합 또는 5항에 있어서, 상기 액상 봉지재 및 물드 처리운드로 물명 후, 150℃ 이상의 고은에서 수시킨 노출시켜 정화시키는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

7. 제1항에 있어서, 상기 반도체때키지의 저면에는 그라인도 (Grind) 를 실시하여 졸대쉬 (Flash) 물 제거하는 것을 특징으로 하는 반도체패키시의 제조방법.

8. 제1함에 있어서, 싱기 물당영역의 의각에 위치한 리드를 절단시 절단은 용이하게 하기 위하여 절단되는 부위의 리드에 노치(Notch)를 형성한을 특징으로 하는 반노제대키지의 제조방법.

9. 서면이 외부로 직접 노출되는 반도체칭과; 상기 반도체칭의 외축에 위치되고 물당영역을 벗어나지 않으며 지면이 외부로 노출되어 저면에서 신호의 입출력이 이루어지는 다수의 리드와: 상기 반도체칭과 리드를 면결시 최주는 와이어와; 상기 반도체칭, 리드 및 와이어를 외부 환경으로부터 보호하기 위하여 물당된 핵상 봉지재또는 컴파운드로 구성된 것을 특징으로 하는 반도체패기지의 구조.

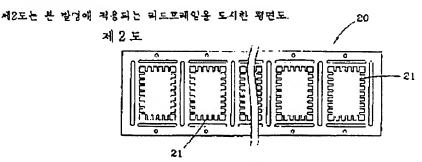
10. 제9함에 있어서, 상기 몰딩된 역상 통기재 및 컨파운드는 리드 및 반도체진의 상부토만 출닝된 것을 복장으로 하는 반도체패키지의 구조.

11. 제9밖에 있어서, 상기 반도체패키지의 자연에는 플래쉬(Flash)의 제거를 위해 그라인드(Grind) 된 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조.

12. 제9함에 있어서, 디드프레임의 나수의 리드 중앙부에는 침탑재관이 없는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조. ·

※ 참고사항: 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면의 긴단한 설명



- 90 -